

Содержание

• Обзоры

Богословский Н.А., Цэндин К.Д.

Физика эффектов переключения и памяти в халькогенидных стеклообразных полупроводниках 577

• Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Авачев А.П., Вихров С.П., Вишняков Н.В., Козюхин С.А., Митрофанов К.В., Теруков Е.И.

Фазовые переходы в тонких пленках халькогенидов $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ по данным комбинационного рассеяния света . 609

Шаров М.К.

Электрофизические свойства твердых растворов серебра в PbTe 613

• Электронные свойства полупроводников

Красавин С.Е.

О влиянии заряженных дислокационных стенок на подвижность в эпитаксиальных слоях GaN 616

Боднарь И.В.

Тепловое расширение и температурная зависимость ширины запрещенной зоны монокристаллов CuIn_5S_8 620

Боднарь И.В., Павлюковец С.А., Труханов С.В., Федотова Ю.А.

Мессбауэровские и магнитные исследования тройного соединения FeIn_2Se_4 624

Литвинов В.В., Петух А.Н., Покотило Ю.М., Маркевич В.П., Ластовский С.Б.

Формирование и отжиг радиационных дефектов в легированных оловом кристаллах германия p -типа 629

Mitzihrta C., Hamilakis S., Kollia C., Loizos Z.

CdSe semiconducting layers produced by pulse electrolysis . 633

Пастор А.А., Сердобинцев П.Ю., Чалдышев В.В.

Экспериментальное определение времени жизни носителей заряда в GaAs , выращенном при низкой температуре . . 637

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Тетельбаум Д.И., Тихов С.В., Курильчик Е.В., Менделева Ю.А.

Дальнействующее влияние облучения кремния светом на фотозд барьера Шоттки 641

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Бондарь Н.В., Бродин М.С.

Фотолюминесценция и энергия экситонов в перколяционном кластере квантовых точек ZnSe как фрактальном объекте 644

Байдусь Н.В., Вайнберг В.В., Звонков Б.Н., Пилипчук А.С., Порошин В.Н., Сарбей О.Г.

Транспортные свойства гетероструктур InGaAs/GaAs с δ -легированными квантовыми ямами 649

Агекян В.Ф., Karczewski G., Серов А.Ю., Филосовов Н.Г.

Люминесценция структур CdMnTe/CdMgTe с периодически расположенными узкозонными включениями 655

Алексеев П.А., Дунаевский М.С., Стовпяга А.В., Lersa M., Титков А.Н.

Определение модуля Юнга нанопроводов GaAs , наклонно растущих на подложке 659

Стрельчук В.В., Николенко А.С., Литвин П.М., Кладько В.П., Гудыменко А.И., Валах М.Я., Красильник З.Ф., Лобанов Д.Н., Новиков А.В.

Эффекты латерального упорядочения самоорганизованных наностроек SiGe , выращенных на напряженных буферных слоях $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 665

Васильев Ю.Б., Михайлов Н.Н., Gouider F., Васильева Г.Ю., Nachtwei G.

Механизм терагерцовой фотопроводимости в полуметаллических квантовых ямах HgTe/CdHgTe 673

• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Снарский А.А., Сарычев А.К., Безсуднов И.В., Лагарьков А.Н.

Термоэлектрическая добротность объемных наноструктурированных композитов с распределенными параметрами 677

• Углеродные системы

Крючков С.В., Кухарь Е.И.

Влияние бихроматического электрического поля на вольт-амперную характеристику сверхрешетки на основе графена 684

• Физика полупроводниковых приборов

Сергеев В.А., Ходаков А.М.

Нелинейная тепловая модель гетеропереходного светодиода 691

Бут Д.Б., Голенков А.Г., Сизов Ф.Ф., Сахно Н.В., Коринец С.В., Гуменюк-Сычевская Ж.В., Рева В.П., Бунчук С.Г.

Кремниевые полевые транзисторы как приемники излучения суб-ТГц диапазона 695

Корнев В.В., Савельев А.В., Жуков А.Е., Омельченко А.В., Максимов М.В.

Влияние неоднородного уширения и преднамеренно внесенной неупорядоченности на ширину спектра генерации лазеров на квантовых точках 701

Ильинская Н.Д., Закгейм А.Л., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Ратушный В.И., Ременный М.А., Рыбальченко А.Ю., Стусь Н.М., Черняков А.Е.

Поверхностно облучаемые фотодиоды на основе InAsSb (длинноволновая граница $\lambda_{0.1} = 4.5$ мкм), работающие при температурах 25–80°С 708

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Сычев М.М., Огурцов К.А., Лебедев В.Т., Кульвеллис Ю.В., Төгök Gy., Соколов А.Е., Трунов В.А., Бахметьев В.В., Котомин А.А., Душенок С.А., Козлов А.С.

Влияние концентрации меди и обработки ZnS на характеристики синтезированных электролюминофоров ZnS : Cu,Cl 714